



「ワイドバンドギャップ半導体基板の研磨・加工技術」

◇ 日時: 2022年8月4日(木) 13:00~18:00

◇ 場所: 大阪大学医学・工学研究科 東京ブランチ@日本橋

東京都中央区日本橋本町 2-3-11 日本橋ライフサイエンスビル 9F

ワイドバンドギャップ半導体の普及に伴い、ウエハの大口径化・低コスト化が求められている。その中でも、基板の研磨・加工技術については、材料を跨いだ議論ができることを期待している。本討論会では、SiC, GaN, Ga₂O₃などのワイドバンドギャップ半導体基板の研磨・加工技術についてスライス技術も含めて、現状の課題や最新動向を踏まえて討論する。

..... プログラム

12:30 開場

13:00~13:10 開会の挨拶、本日の進行説明

13:10~14:00 イントロダクトリー

大口径・低コスト化に向けた SiC ウエハの加工技術

加藤 智久 (産業技術総合研究所)

14:00~14:40 固体高分子電解質含有パッドを用いた SiC の電気化学機械研磨

村田 順二 (立命館大学)

14:40~14:50 休 憩

14:50~15:30 次世代半導体向けマルチワイヤ放電スライス技術

湯澤 隆 (三菱電機株式会社)

15:30~16:10 レーザを用いた GaN 基板のスライス

田中 敦之 (名古屋大学)

16:10~16:20 休 憩

16:20~17:00 ミラー電子顕微鏡分析を用いた SiC ウェハ加工品質向上

池内 隆啓 (六甲電子株式会社)

17:00~17:55 参加者からの情報提供も踏まえた全体討議

17:55~18:00 閉会の挨拶

.....

■参加について: ワイドバンドギャップ半導体基板の研磨・加工技術に関して、最新の動向を踏まえて討論する、全員参加で議論を行う討論会です。討論会の性質上、参加者の方に意見や発言を求めるときがございますのでご理解下さい。また、WEBから参加申し込みを行っていただく際に、議論できる内容や取り組んでいる研究の概要や提供可能な話題などについて可能な範囲で記述をお願い致します。

■**参加受付:** WEB参加受付システム([ここをクリック](#))から参加登録をお願いします。締切7月27日(水)。
定員25名。定員に達しましたら参加受付を終了させていただきますので、申込みはお早めをお願いします。
予稿集は、後日参加者の皆様へPDFのダウンロード先を通知させていただきます。

■**参加費:**(消費税込み)

先進パワー半導体分科会会員* 2,000円、一般 4,000円、学生(分科会会員・一般) 1,000円

■**感染症対策:** 事前の検温にご協力頂き、発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。また、会場入り口での再度の検温にご協力下さい(体温が37.5度以上ある場合、ご参加頂けません)。会場では、消毒およびマスクの常時着用をお願い致します。

■**問い合わせ先:**

堀切 文正((株)サイオクス)

TEL: 0294-42-5025, e-mail: horikirif@sc.sumitomo-chem.co.jp

佐野 泰久(大阪大学)

TEL: 06-6879-7284, e-mail: sano@prec.eng.osaka-u.ac.jp

児島 一聡(産業技術総合研究所)

TEL: 029-861-5728, e-mail: kazu-kojima@aist.go.jp